

PATENT  
81754.0110  
Express Mail Label No. EV 324 112 398 US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:	Art Unit: Not assigned
Takayoshi OBINATA	Examiner: Not assigned
Serial No: Not assigned	
Filed: March 15, 2004	
For: Semiconductor Wafer, Semiconductor Device and Method for Manufacturing Same, Circuit Board, and Electronic Apparatus	

**TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT**

Mail Stop PATENT APPLICATION  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

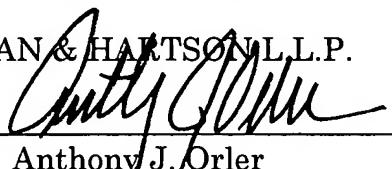
Enclosed herewith is a certified copy of Japanese patent application No. 2003-078097 which was filed March 20, 2003, from which priority is claimed under 35 U.S.C. § 119 and Rule 55.

Acknowledgment of the priority document(s) is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,

HOGAN & HARTSON L.L.P.

Date: March 15, 2004

By:   
Anthony J. Orler  
Registration No. 41,232  
Attorney for Applicant(s)

500 South Grand Avenue, Suite 1900  
Los Angeles, California 90071  
Telephone: 213-337-6700  
Facsimile: 213-337-6701



日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 3月20日

出願番号 Application Number: 特願2003-078097

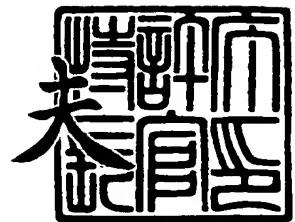
[ST. 10/C]: [JP2003-078097]

出願人 Applicant(s): セイコーエプソン株式会社

2003年11月21日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

EP-0437601

【提出日】

平成15年 3月20日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 23/12

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 大日方 孝好

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090479

【弁理士】

【氏名又は名称】 井上 一

【電話番号】 03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】 100090387

【弁理士】

【氏名又は名称】 布施 行夫

【電話番号】 03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】 100090398

【弁理士】

【氏名又は名称】 大渕 美千栄

【電話番号】 03-5397-0891

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 039491

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9402500

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体ウエハ、半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 集積回路と、前記集積回路に電気的に接続する配線と、が形成されており、前記配線の一部であるパッドを表面に含む半導体チップと、前記パッドと電気的に接続してなる再配線層と、前記再配線層の上方に、前記再配線層に電気的に接続して設けられた外部端子と、前記外部端子を囲むとともに、前記半導体チップの側面に至るように設けられてなる樹脂層と、を含む半導体装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の半導体装置において、前記半導体チップは、その端部に薄肉部を有し、前記樹脂層は、前記薄肉部上に至るように形成されてなる半導体装置。

【請求項 3】 請求項 2 記載の半導体装置において、前記半導体チップは、前記表面から直角に下がる第 1 の面と、前記表面とは反対側の裏面から直角に上がる第 2 の面と、前記表面と平行になっており前記第 1 及び第 2 の面を接続する第 3 の面と、を有し、前記樹脂層は、前記第 2 の面を避けるように前記第 1 の面上に形成されてなる半導体装置。

【請求項 4】 請求項 2 記載の半導体装置において、前記半導体チップは、前記表面から直角に下がる第 1 の面と、前記表面とは反対側の裏面から直角に上がる第 2 の面と、屈曲して前記第 1 及び第 2 の面を接続する第 3 の面と、を有し、前記樹脂層は、前記第 2 の面を避けるように前記第 1 の面上に形成されてなる半導体装置。

【請求項 5】 請求項 3 又は請求項 4 記載の半導体装置において、

前記樹脂層は、さらに、前記第3の面上に形成されてなる半導体装置。

**【請求項6】** 請求項2記載の半導体装置において、

前記半導体チップは、前記表面から下がる第1の面と、前記表面とは反対側の裏面から上がる第2の面と、を含み、前記第1及び第2の面は異なる角度で形成されており、

前記樹脂層は、前記第2の面を避けるように前記第1の面上に形成されてなる半導体装置。

**【請求項7】** 請求項2記載の半導体装置において、

前記半導体チップは、前記表面から屈曲して下がる第1の面と、前記表面とは反対側の裏面から平坦に上がる第2の面と、を含み、

前記樹脂層は、前記第2の面を避けるように前記第1の面上に形成されてなる半導体装置。

**【請求項8】** 請求項1から請求項7のいずれかに記載の半導体装置において、

前記半導体チップ上に形成された応力緩和層をさらに有し、

前記再配線層は、前記応力緩和層上に形成され、

前記樹脂層は、前記応力緩和層の上方に形成されてなる半導体装置。

**【請求項9】** 請求項1から請求項8のいずれかに記載の半導体装置において、

前記外部端子を設ける領域を除いて前記再配線層を覆うように形成されたレジスト層をさらに有し、

前記樹脂層は、前記レジスト層の上方に形成されてなる半導体装置。

**【請求項10】** 請求項1から請求項9のいずれかに記載の半導体装置が実装された回路基板。

**【請求項11】** 請求項1から請求項9のいずれかに記載の半導体装置を有する電子機器。

**【請求項12】** 複数の集積回路と、それぞれの前記集積回路に電気的に接続する配線と、が形成されており、前記配線の一部であるパッドを表面に含み、前記表面には溝が形成されてなる半導体基板と、

前記パッドと電気的に接続してなる再配線層と、  
前記再配線層の上方に、前記再配線層に電気的に接続して設けられた外部端子  
と、  
前記外部端子を囲むとともに前記溝を覆うように設けられてなる樹脂層と、  
を含む半導体ウエハ。

**【請求項 13】** 請求項12記載の半導体ウエハにおいて、  
前記溝は、それぞれの前記集積回路を囲むように形成されてなる半導体ウエハ  
。

**【請求項 14】** 請求項12又は請求項13記載の半導体ウエハにおいて、  
前記溝の側面と底面は、曲面によって接続されてなる半導体ウエハ。

**【請求項 15】** 請求項12から請求項14のいずれかに記載の半導体ウエ  
ハにおいて、

前記溝の側面は傾斜してなる半導体ウエハ。

**【請求項 16】** 請求項12から請求項15のいずれかに記載の半導体ウエ  
ハにおいて、

前記半導体基板上に形成された応力緩和層をさらに有し、  
前記再配線層は、前記応力緩和層上に形成され、  
前記樹脂層は、前記応力緩和層の上方に形成されてなる半導体ウエハ。

**【請求項 17】** 請求項12から請求項16のいずれかに記載の半導体ウエ  
ハにおいて、

前記外部端子を設ける領域を除いて前記再配線層を覆うように形成されたレジ  
スト層をさらに有し、

前記樹脂層は、前記レジスト層の上方に形成されてなる半導体ウエハ。

**【請求項 18】** (a) 複数の集積回路と、それぞれの前記集積回路に電気  
的に接続する配線と、が形成されており、前記配線の一部であるパッドを表面に  
含む半導体基板の前記表面に溝を形成すること、

(b) 前記パッドと電気的に接続するように再配線層を形成すること、

(c) 前記再配線層の上方に、前記再配線層に電気的に接続するように外部端  
子を設けること、

(d) 前記外部端子を囲むとともに前記溝を覆うように樹脂層を設けること、及び、その後、

(e) 前記溝内で、前記半導体基板を前記樹脂層とともに切断すること、を含む半導体装置の製造方法。

**【請求項19】** 請求項18記載の半導体装置の製造方法において、前記溝を、それぞれの前記集積回路を囲むように形成する半導体装置の製造方法。

**【請求項20】** 請求項18又は請求項19記載の半導体装置の製造方法において、

前記溝を、その側面及び底面が曲面によって接続されるように形成する半導体装置の製造方法。

**【請求項21】** 請求項18から請求項20のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、

前記溝を、その側面が傾斜するように形成する半導体装置の製造方法。

**【請求項22】** 請求項18から請求項21のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、

前記(b)工程前に、前記半導体基板上に応力緩和層を形成することをさらに含み、

前記(b)工程で、前記再配線層を、前記応力緩和層上に形成し、

前記(d)工程で、前記樹脂層を、前記応力緩和層の上方に形成する半導体装置の製造方法。

**【請求項23】** 請求項18から請求項22のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、

前記(c)工程前に、前記外部端子を設ける領域を除いて前記再配線層を覆うようにレジスト層を形成することをさらに含み、

前記(d)工程で、前記樹脂層を、前記レジスト層の上方に形成する半導体装置の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【0001】

**【発明の属する技術分野】**

本発明は、半導体ウエハ、半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器に関する。

**【0002】****【従来の技術】****【0003】****【特許文献1】**

国際公開第WO98/32170号パンフレット

**【0004】****【発明の背景】**

半導体装置の高密度実装を追及すると、ペアチップ実装が理想的である。しかしながら、ペアチップは、品質の保証及び取り扱いが難しい。そこで、CSP (Chip Scale/Size Package) が適用された半導体装置が開発されている。特に近年、ウエハレベルCSPが注目されている。ウエハレベルCSPでは、ウエハレベルで樹脂層の形成を含むパッケージングを行う。その後、ウエハを個々のパッケージに切り出すときに、樹脂層を切断する場合があり、その場合、切断された樹脂層は、その切断面から剥離しやすいという問題があった。

**【0005】**

本発明は、樹脂層の剥離を防止又は抑制することを目的とする。

**【0006】****【課題を解決するための手段】**

(1) 本発明に係る半導体装置は、集積回路と、前記集積回路に電気的に接続する配線と、が形成されており、前記配線の一部であるパッドを表面に含む半導体チップと、

前記パッドと電気的に接続してなる再配線層と、

前記再配線層の上方に、前記再配線層に電気的に接続して設けられた外部端子と、

前記外部端子を囲むとともに、前記半導体チップの側面に至るように設けられてなる樹脂層と、

を含む。本発明によれば、樹脂層は、半導体チップの側面に至るので剥離しにくくなっている。また、樹脂層が収縮しようとしても、半導体チップの側面で樹脂層の端部が引っかかるようになっているので、樹脂層と半導体チップの密着性が高い。

(2) この半導体装置において、

前記半導体チップは、その端部に薄肉部を有し、

前記樹脂層は、前記薄肉部上に至るように形成されていてもよい。

(3) この半導体装置において、

前記半導体チップは、前記表面から直角に下がる第1の面と、前記表面とは反対側の裏面から直角に上がる第2の面と、前記表面と平行になっており前記第1及び第2の面を接続する第3の面と、を有し、

前記樹脂層は、前記第2の面を避けるように前記第1の面上に形成されていてもよい。

(4) この半導体装置において、

前記半導体チップは、前記表面から直角に下がる第1の面と、前記表面とは反対側の裏面から直角に上がる第2の面と、屈曲して前記第1及び第2の面を接続する第3の面と、を有し、

前記樹脂層は、前記第2の面を避けるように前記第1の面上に形成されていてもよい。

(5) この半導体装置において、

前記樹脂層は、さらに、前記第3の面上に形成されていてもよい。

(6) この半導体装置において、

前記半導体チップは、前記表面から下がる第1の面と、前記表面とは反対側の裏面から上がる第2の面と、を含み、前記第1及び第2の面は異なる角度で形成されており、

前記樹脂層は、前記第2の面を避けるように前記第1の面上に形成されていてもよい。

(7) この半導体装置において、

前記半導体チップは、前記表面から屈曲して下がる第1の面と、前記表面とは

反対側の裏面から平坦に上がる第2の面と、を含み、

前記樹脂層は、前記第2の面を避けるように前記第1の面上に形成されていてもよい。

(8) この半導体装置は、

前記半導体チップ上に形成された応力緩和層をさらに有し、

前記再配線層は、前記応力緩和層上に形成され、

前記樹脂層は、前記応力緩和層の上方に形成されていてもよい。

(9) この半導体装置は、

前記外部端子を設ける領域を除いて前記再配線層を覆うように形成されたレジスト層をさらに有し、

前記樹脂層は、前記レジスト層の上方に形成されていてもよい。

(10) 本発明に係る回路基板は、上記半導体装置が実装されてなる。

(11) 本発明に係る電子機器は、上記半導体装置を有する。

(12) 本発明に係る半導体ウエハは、複数の集積回路と、それぞれの前記集積回路に電気的に接続する配線と、が形成されており、前記配線の一部であるパッドを表面に含み、前記表面には溝が形成されてなる半導体基板と、

前記パッドと電気的に接続してなる再配線層と、

前記再配線層の上方に、前記再配線層に電気的に接続して設けられた外部端子と、

前記外部端子を囲むとともに前記溝を覆うように設けられてなる樹脂層と、を含む。本発明によれば、樹脂層は、溝でその一部が引っかかるようになっているので、半導体基板との密着性が高く、剥離しにくくなっている。

(13) この半導体ウエハにおいて、

前記溝は、それぞれの前記集積回路を囲むように形成されていてもよい。

(14) この半導体ウエハにおいて、

前記溝の側面と底面は、曲面によって接続されていてもよい。

(15) この半導体ウエハにおいて、

前記溝の側面は傾斜していてもよい。

(16) この半導体ウエハは、

前記半導体基板上に形成された応力緩和層をさらに有し、

前記再配線層は、前記応力緩和層上に形成され、

前記樹脂層は、前記応力緩和層の上方に形成されていてもよい。

(17) この半導体ウエハは、

前記外部端子を設ける領域を除いて前記再配線層を覆うように形成されたレジスト層をさらに有し、

前記樹脂層は、前記レジスト層の上方に形成されていてもよい。

(18) 本発明に係る半導体装置の製造方法は、(a) 複数の集積回路と、それぞれの前記集積回路に電気的に接続する配線と、が形成されており、前記配線の一部であるパッドを表面に含む半導体基板の前記表面に溝を形成すること、

(b) 前記パッドと電気的に接続するように再配線層を形成すること、

(c) 前記再配線層の上方に、前記再配線層に電気的に接続するように外部端子を設けること、

(d) 前記外部端子を囲むとともに前記溝を覆うように樹脂層を設けること、及び、その後、

(e) 前記溝内で、前記半導体基板を前記樹脂層とともに切断すること、を含む。本発明によれば、半導体基板に設けられた樹脂層は溝でその一部が引っかかるようになっている。半導体基板及び樹脂層を溝内で切断しても、樹脂層は、溝の側面で引っかかるようになる。したがって、樹脂層の剥離を防止することができる。

(19) この半導体装置の製造方法において、

前記溝を、それぞれの前記集積回路を囲むように形成してもよい。

(20) この半導体装置の製造方法において、

前記溝を、その側面及び底面が曲面によって接続されるように形成してもよい。

。

(21) この半導体装置の製造方法において、

前記溝を、その側面が傾斜するように形成してもよい。

(22) この半導体装置の製造方法は、

前記(b)工程前に、前記半導体基板上に応力緩和層を形成することをさらに

含み、

前記（b）工程で、前記再配線層を、前記応力緩和層上に形成し、

前記（d）工程で、前記樹脂層を、前記応力緩和層の上方に形成してもよい。

（23）この半導体装置の製造方法は、

前記（c）工程前に、前記外部端子を設ける領域を除いて前記再配線層を覆う  
ようにレジスト層を形成することをさらに含み、

前記（d）工程で、前記樹脂層を、前記レジスト層の上方に形成してもよい。

### 【0007】

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

### 【0008】

#### （第1の実施の形態）

図1～図4は、本発明の第1の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。本実施の形態では、半導体基板10を使用する。半導体基板10には、集積回路12が形成されている。半導体基板10を複数の半導体チップに切り出す場合、半導体基板10には、複数の集積回路12が形成され、個々の半導体チップが個々の集積回路12を有することになる。

### 【0009】

半導体基板10の表面には、パッシベーション膜14が形成されていてもよい。例えば、SiO<sub>2</sub>又はSiN等の無機材料でパッシベーション膜14を形成してもよい。パッシベーション膜14を複数層で形成してもよい。その場合、少なくとも1層（例えば表面層）を有機材料で形成してもよい。

### 【0010】

半導体基板10（その表面）には、パッド16が形成されている。パッド16は、集積回路（例えば半導体集積回路）12に電気的に接続された配線の一部（例えば端部）である。パッシベーション膜14は、パッド16の少なくとも中央部を避けて形成されている。

### 【0011】

本実施の形態では、半導体基板10（パッド16が形成された表面）に溝18

を形成する。図2に示すように、溝18は、格子状に形成してもよい。溝18は、各集積回路12を囲むように形成してもよい。溝18の形成は、後述する応力緩和層20及びレジスト層24を形成する前に行つてもよいし、これらの形成後に行つてもよい。

#### 【0012】

図1に示すように、半導体基板10に応力緩和層20を形成してもよい。応力緩和層20は、半導体基板10に樹脂前駆体（例えば熱硬化性樹脂前駆体）を塗布して形成してもよいし、半導体基板10上で樹脂前駆体をスピンドルコートによって拡げて形成してもよい。応力緩和層20は、複数層で形成してもよいし、1層で形成しもよい。応力緩和層20は、電気的絶縁層である。応力緩和層20は、ポリイミド樹脂、シリコーン変性ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン変性エポキシ樹脂、ベンゾシクロブテン（B C B ; benzocyclobutene）、ポリベンゾオキサゾール（P B O ; polybenzoxazole）等で形成してもよい。応力緩和層20は、導電性粒子を含まない。応力緩和層20は、遮光性を有する材料で形成してもよい。

#### 【0013】

応力緩和層20は、放射線（光線（紫外線、可視光線）、X線、電子線）に感應する性質を有する放射線感應性樹脂前駆体で形成してもよい。放射線感應性樹脂前駆体（例えば感光性樹脂前駆体）として、放射線の照射された部分の溶解性が減少して不溶性となるネガ型と、放射線の照射された部分の溶解性が増加するポジ型がある。

#### 【0014】

応力緩和層20は、パッド16上を避けるように形成してもよい。応力緩和層20は、溝18を避けるように（溝18内に入らないように）形成する。応力緩和層20は、半導体基板10の切断用領域を避けるように形成してもよい。応力緩和層20は、半導体基板10上に連続的又は一体的に形成した後にパターニングしてもよい。その場合、パターニング前には、溝18内に応力緩和層20が一時的に形成されていてもよい。半導体基板10の複数領域（複数の集積回路12が形成された領域）のそれぞれに、応力緩和層20を形成してもよい。隣同士の

応力緩和層20の間にはスペースがある。

### 【0015】

応力緩和層20上に再配線層22を形成する。再配線層22は、1層で形成してもよいし、複数層で形成してもよい。例えば、スパッタリングでTiW層及びCu層を積層し、その上にメッキによってCu層を形成してもよい。その形成方法には、公知の技術を適用することができる。再配線層22は、パッド16上を通るように（パッド16と電気的に接続されるように）形成する。再配線層22は、パッド16上から応力緩和層20上に形成する。再配線層22は、ランド（ラインよりも幅の広い部分）を有するように形成してもよい。ランドは、その上に外部端子26を設けるためのものである。

### 【0016】

応力緩和層20上にレジスト層24を形成してもよい。レジスト層24はソルダレジストであってもよい。レジスト層24は、再配線層22の全体あるいは一部（例えば外部端子26を設ける領域を除く部分）を覆うように形成してもよい。レジスト層24は、応力緩和層20を覆うように（例えば完全に覆うように）形成してもよい。レジスト層24は、半導体基板10の切断用領域が露出するように（切断用領域を避けるように）形成してもよい。レジスト層24は、溝18を避けるように（溝18内に入らないように）形成する。レジスト層24は、半導体基板10上に連続的又は一体的に形成した後にパターニングしてもよい。その場合、パターニング前には、溝18内にレジスト層24が一時的に形成されていてもよい。半導体基板10の複数領域（複数の集積回路12が形成された領域）のそれぞれに、レジスト層24を形成してもよい。隣同士のレジスト層24の間にはスペースがある。

### 【0017】

外部端子26を形成する。外部端子26は再配線層22上（又は上方）に形成する。外部端子26は、軟ろう（soft solder）又は硬ろう（hard solder）のいずれで形成してもよい。軟ろうとして、鉛を含まないハンダ（以下、鉛フリーハンダという。）を使用してもよい。鉛フリーハンダとして、スズ-銀（Sn-Ag）系、スズ-ビスマス（Sn-Bi）系、スズ-亜鉛（Sn-Zn）系、ある

いはスズ-銅 (Sn-Cu) 系の合金を使用してもよいし、これらの合金に、さらに銀、ビスマス、亜鉛、銅のうち少なくとも1つを添加してもよい。外部端子26の形成には、周知の方法を適用することができる。

#### 【0018】

図3に示すように、レジスト層24上に樹脂層30を形成する。樹脂層30には、応力緩和層20の内容が該当してもよい。樹脂層30は、溝18を覆うように設ける。溝18内の領域で、樹脂層30の表面が窪んでいてもよい。樹脂層30は、外部端子26を囲むように設ける。樹脂層30は、外部端子26の一部（例えば根本部）を覆っていてもよい。樹脂層30は、レジスト層24を覆うように（例えば完全に覆うように）形成してもよい。樹脂層30は、半導体基板10の全体を覆うように形成した後にパターニングしてもよい。樹脂層30を、外部端子26が覆われるよう設けた後、外部端子26の上端部から樹脂層30を除去してもよい。パターニングには、応力緩和層20のパターニングで説明した内容を適用することができる。あるいは、レーザの使用又はアッシングによって、樹脂層30の一部を除去してもよい。

#### 【0019】

本発明の実施の形態に係る半導体ウエハは、半導体基板10を有する。半導体基板10には、複数の集積回路12（図1参照）が形成され、表面にパッド16が形成されている。パッド16は、それぞれの集積回路12に電気的に接続する配線の一部である。半導体基板10には溝18が形成されている。パッド16と電気的に接続するように再配線層22が形成されている。再配線層22の上方に、再配線層22に電気的に接続するように外部端子26が形成されている。外部端子26を囲むように樹脂層30が形成されている。樹脂層30は、溝18を覆うように形成されている。その他の詳細については、上述した通りである。本実施の形態によれば、樹脂層30は、溝18でその一部が引っかかるようになってるので、半導体基板10との密着性が高く、剥離しにくくなっている。

#### 【0020】

図4に示すように、半導体基板10を、例えばカッタ（又はブレード）32等によって、切断（例えば、スクライビング又はダイシング）する。半導体基板1

0及び樹脂層30とともに切断する。切断は、溝18内で行う。半導体基板10及び樹脂層30を切断しても、樹脂層30は、溝18の側面で引っかかるようになるので、樹脂層30の剥離を防止することができる。こうして、半導体装置を得ることができる。

### 【0021】

図5は、本実施の形態に係る半導体装置を説明する図であり、図6は、図5のVI-VI線断面図である。半導体装置は、半導体チップ40を有する。半導体チップ40は、半導体基板10から切り出されたものであってもよい。半導体チップ40には、集積回路12（図1参照）が形成され、表面にパッド16が形成されている。パッド16は、集積回路12に電気的に接続する配線の一部である。半導体チップ40には応力緩和層20が形成されている。応力緩和層20上に、パッド16と電気的に接続するように再配線層22が形成されている。再配線層22の上方に、再配線層22に電気的に接続するように外部端子26が形成されている。半導体装置は、樹脂層30を有する。樹脂層30は、外部端子26を囲む。樹脂層30は、半導体チップ40の側面に至るように設けられている。

### 【0022】

半導体チップ40は、その端部に薄肉部42を有する。詳しくは、半導体チップ40は、パッド16が形成された表面44から直角に下がる第1の面46と、表面44とは反対側の裏面48から直角に上がる第2の面50と、表面44と平行になっており第1及び第2の面46, 50を接続する第3の面52と、を有する。樹脂層30は、薄肉部42上に至るように形成されている。樹脂層30は、第2の面50を避けるように第1の面46上に形成されていてもよい。樹脂層30は、さらに、第3の面52上に形成されてもよい。その他の詳細については、上述した通りである。

### 【0023】

本実施の形態によれば、樹脂層30は、半導体チップ40の側面に至るので剥離しにくくなっている。また、樹脂層30が収縮しようとしても、半導体チップ40の側面で樹脂層30の端部が引っかかるようになっているので、樹脂層30と半導体チップ40の密着性が高い。

### 【0024】

#### (第2の実施の形態)

図7は、本発明の第2の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す図である。本実施の形態では、半導体基板10に形成する溝58の形状が、第1の実施の形態で説明した溝18と異なる。それ以外の内容は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。溝58は、例えば、U溝又は丸（半円）溝である。溝58の底面が曲面である。溝58の側面は、曲面であってもよいし傾斜するように形成してもよい。溝58は、その側面及び底面が曲面によって接続されるように形成する。本実施の形態では、半導体基板10に溝58を形成し、その後、第1の実施の形態で説明した工程を行って、半導体装置を得る。なお、溝58は、底面と側面が曲面で接続されている（角がない）ので、樹脂層68と溝58の内面との間に隙間が形成されにくい。

### 【0025】

図8は、図7に示す半導体基板から得られた半導体装置を示す図である。溝58がU溝であれば、半導体チップ60の表面44から第1の面62は直角に下がる。溝58が丸（半円）溝であれば、半導体チップ60の表面44から第1の面62は屈曲して下がる。表面44とは反対側の裏面48から第2の面64が直角に上がる。第3の面66は、屈曲して第1及び第2の面62, 64を接続する。樹脂層30と同じ内容が該当する樹脂層68は、第2の面64を避けるように第1の面62上に形成されている。樹脂層68は、さらに、第3の面66上に形成されていてもよい。その他の内容は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。

### 【0026】

#### (第3の実施の形態)

図9は、本発明の第3の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す図である。本実施の形態では、半導体基板10に形成する溝70の形状が、第1の実施の形態で説明した溝18と異なる。それ以外の内容は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。溝70は、例えば、V溝である。溝70の側面は傾斜している。本実施の形態では、半導体基板10に溝70を形成し、その後、第1の実

施の形態で説明した工程を行って、半導体装置を得る。

### 【0027】

図10は、図9に示す半導体基板から得られた半導体装置を示す図である。半導体装置において、半導体チップ72は、表面44から下がる第1の面74と、表面44とは反対側の裏面48から上がる第2の面76と、を含む。第1及び第2の面74、76は、表面44に対して異なる角度で形成されている。樹脂層30と同じ内容が該当する樹脂層78は、第2の面76を避けるように第1の面74上に形成されている。その他の内容は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。

### 【0028】

#### (第4の実施の形態)

図11は、本発明の第4の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す図である。本実施の形態では、半導体基板10に形成する溝80の形状が、第1の実施の形態で説明した溝18と異なる。それ以外の内容は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。溝80は、例えば、曲面からなる溝である。半導体基板10の表面と溝80とが曲面で滑らかに接続されている。本実施の形態では、半導体基板10に溝80を形成し、その後、第1の実施の形態で説明した工程を行って、半導体装置を得る。なお、溝80は、底面と側面が曲面で接続されている（角がない）ので、樹脂層88と溝80の内面との間に隙間が形成されにくい。

### 【0029】

図12は、図10に示す半導体基板から得られた半導体装置を示す図である。半導体装置において、半導体チップ82は、表面44から屈曲して下がる第1の面84と、表面44とは反対側の裏面48から平坦に上がる第2の面86と、を含む。樹脂層30と同じ内容が該当する樹脂層88は、第2の面86を避けるように第1の面84上に形成されている。その他の内容は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。

### 【0030】

#### (第5の実施の形態)

図13は、本発明の第5の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を示す図で

ある。本実施の形態では、半導体基板10の切断用領域に、複数（例えば2つ）の溝90を並列するように形成する。複数の刃が重ねられてなるカッタによって、複数の溝90を同時に形成してもよい。これ例外の内容は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。各溝90の形状は、第1～第4の実施の形態で説明した溝の内容を適用することができる。本実施の形態では、半導体基板10の切断用領域に溝90を形成し、その後、第1の実施の形態で説明した工程を行う。半導体基板10を切断するときには、切断用領域内で、並列する溝90に挟まれた領域を除去する。図13に示すように、並列する溝90のピッチ長さと同等又はそれを超える厚みを有する比較的厚いカッタ100によって半導体基板10を切断してもよい。こうして、半導体装置を得る。

### 【0031】

図14は、図13に示す半導体基板から得られた半導体装置を示す図である。樹脂層30と同じ内容が該当する樹脂層98は、半導体チップ92の側面に至るように設けられてなる。半導体チップ92の端部の形状は、各溝90の形状に応じたものであり、その詳細は、第1～第4の実施の形態で説明した通りである。また、その他の内容は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。

### 【0032】

図15には、上述した実施の形態で説明した半導体装置1が実装された回路基板1000が示されている。この半導体装置を有する電子機器として、図16にはノート型パーソナルコンピュータ2000が示され、図17には携帯電話3000が示されている。

### 【0033】

本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び結果が同一の構成）を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加した構成を含む。

**【図面の簡単な説明】**

**【図 1】** 図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。

**【図 2】** 図 2 は、溝の形状を説明する図である。

**【図 3】** 図 3 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。

**【図 4】** 図 4 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。

**【図 5】** 図 5 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る半導体装置を説明する図である。

**【図 6】** 図 6 は、図 5 の VI-VI 線断面の一部拡大図である。

**【図 7】** 図 7 は、本発明の第 2 の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。

**【図 8】** 図 8 は、本発明の第 2 の実施の形態に係る半導体装置を説明する図である。

**【図 9】** 図 9 は、本発明の第 3 の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。

**【図 10】** 図 10 は、本発明の第 3 の実施の形態に係る半導体装置を説明する図である。

**【図 11】** 図 11 は、本発明の第 4 の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。

**【図 12】** 図 12 は、本発明の第 4 の実施の形態に係る半導体装置を説明する図である。

**【図 13】** 図 13 は、本発明の第 5 の実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。

**【図 14】** 図 14 は、本発明の第 5 の実施の形態に係る半導体装置を説明する図である。

**【図 15】** 図 15 は、本実施の形態に係る半導体装置が実装された回路基板を示す図である。

【図16】 図16は、本実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器を示す図である。

【図17】 図17は、本実施の形態に係る半導体装置を有する電子機器を示す図である。

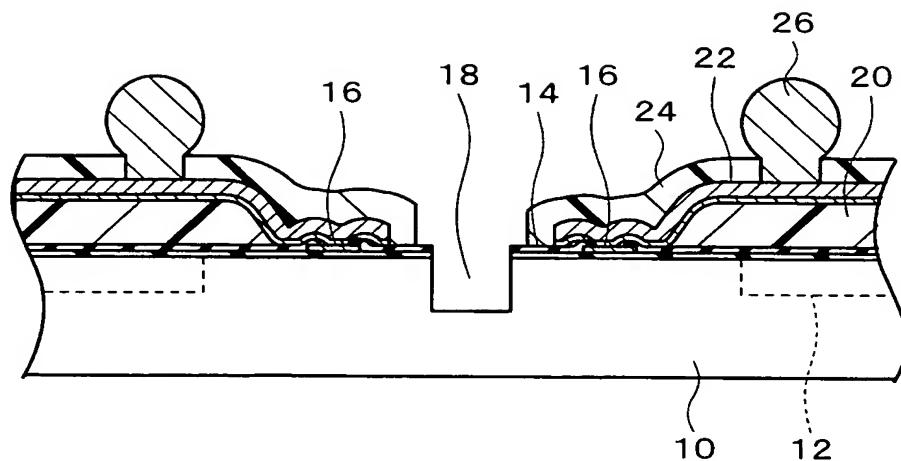
【符号の説明】

10…半導体基板 12…集積回路 14…パッシベーション膜 16…パッド  
20…応力緩和層 22…再配線層 24…レジスト層 26…外部端子  
30…樹脂層 40…半導体チップ 42…薄肉部 44…表面 48…裏面  
60…半導体チップ 68…樹脂層 72…半導体チップ 78…樹脂層 82…半導体チップ 88…樹脂層 90…溝 92…半導体チップ 98…樹脂層

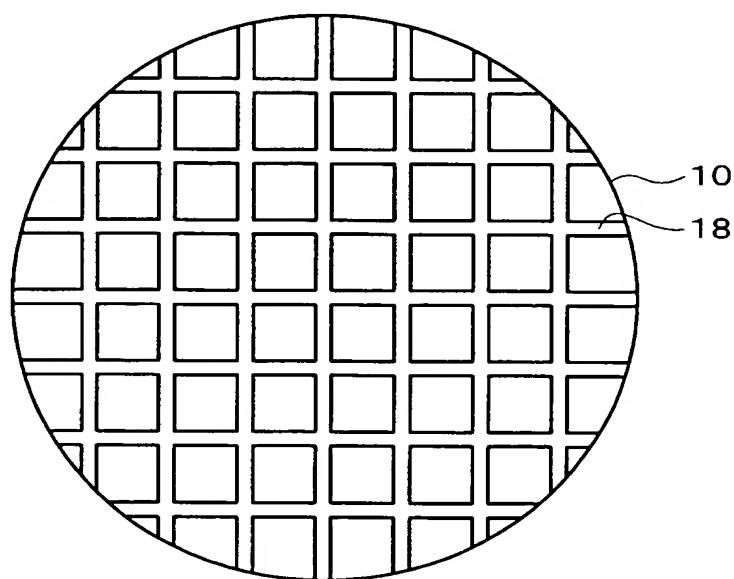
【書類名】

図面

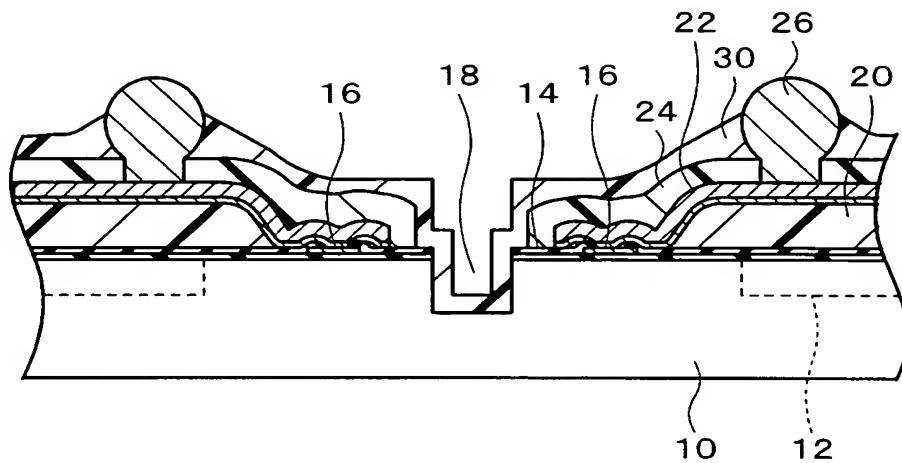
【図1】



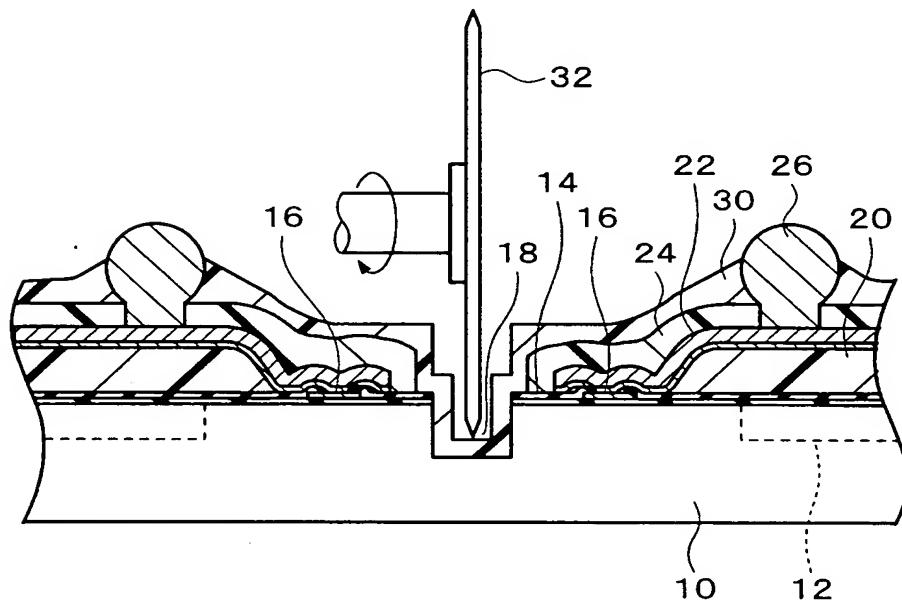
【図2】



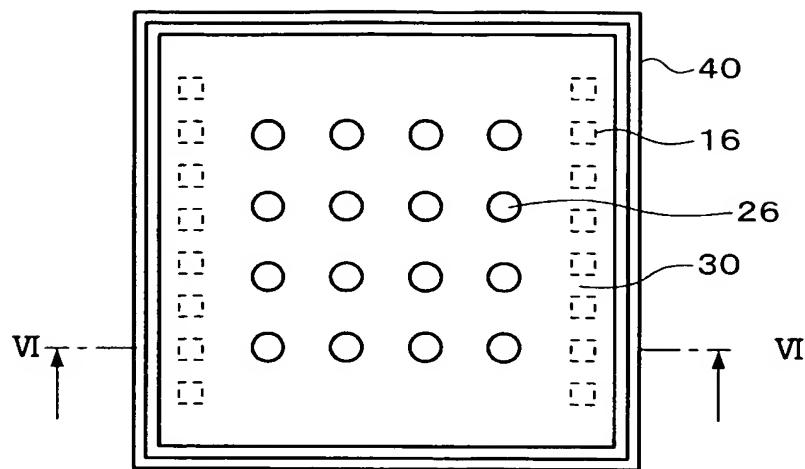
【図3】



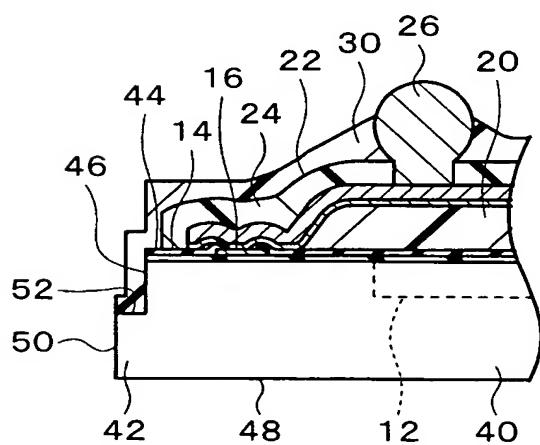
【図4】



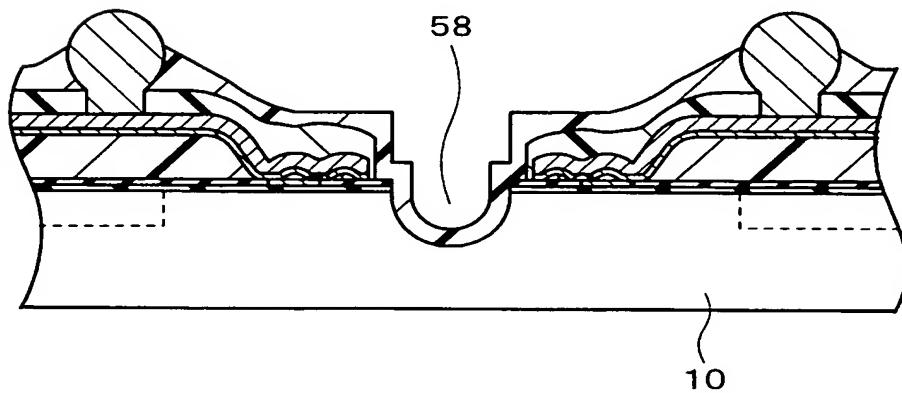
【図 5】



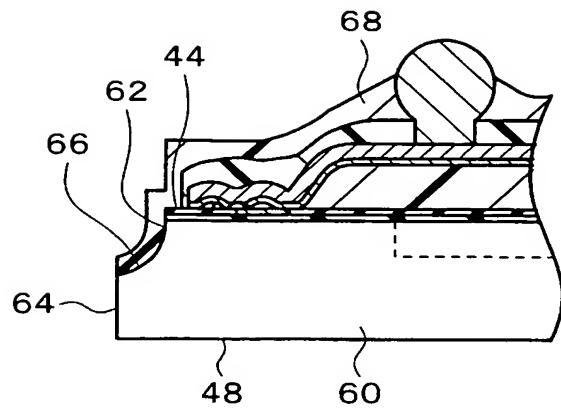
【図 6】



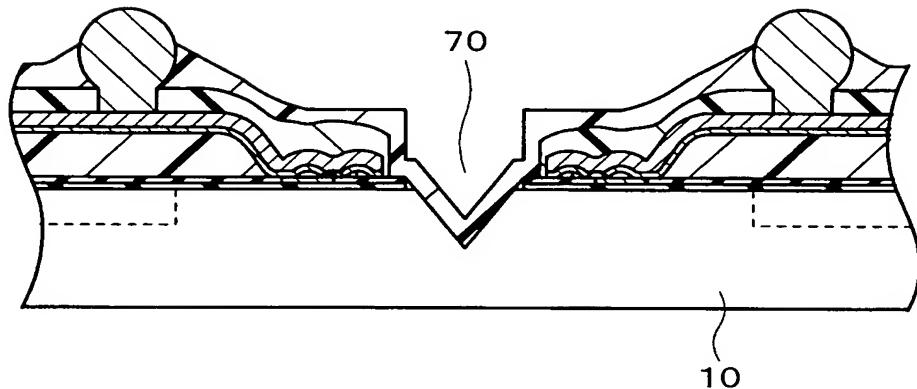
【図 7】



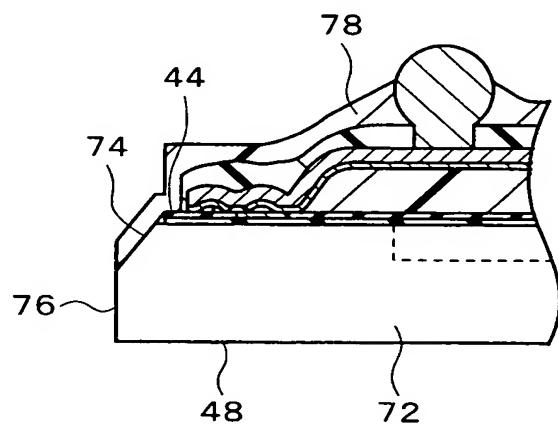
【図8】



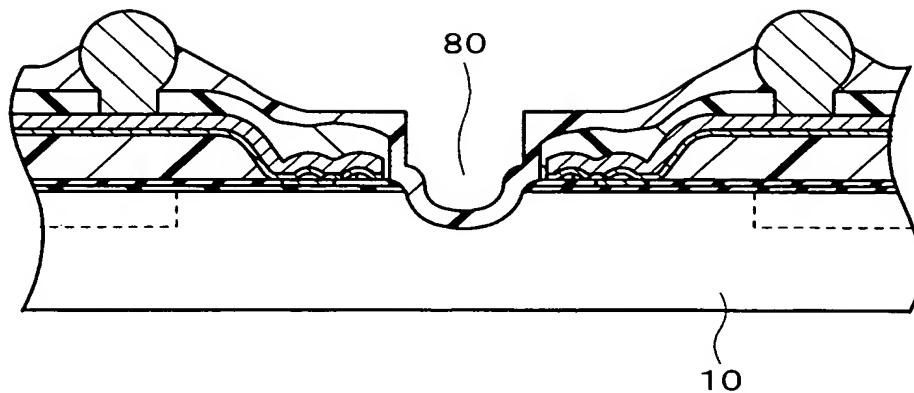
【図9】



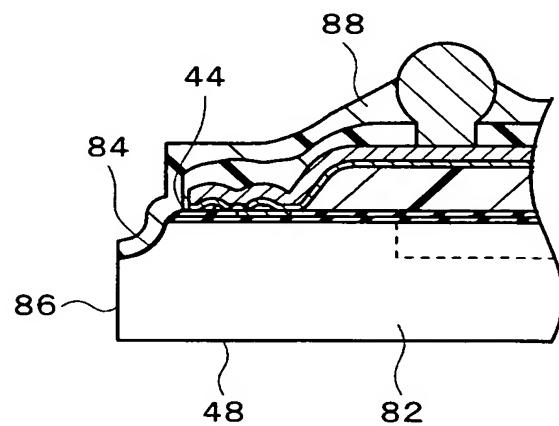
【図10】



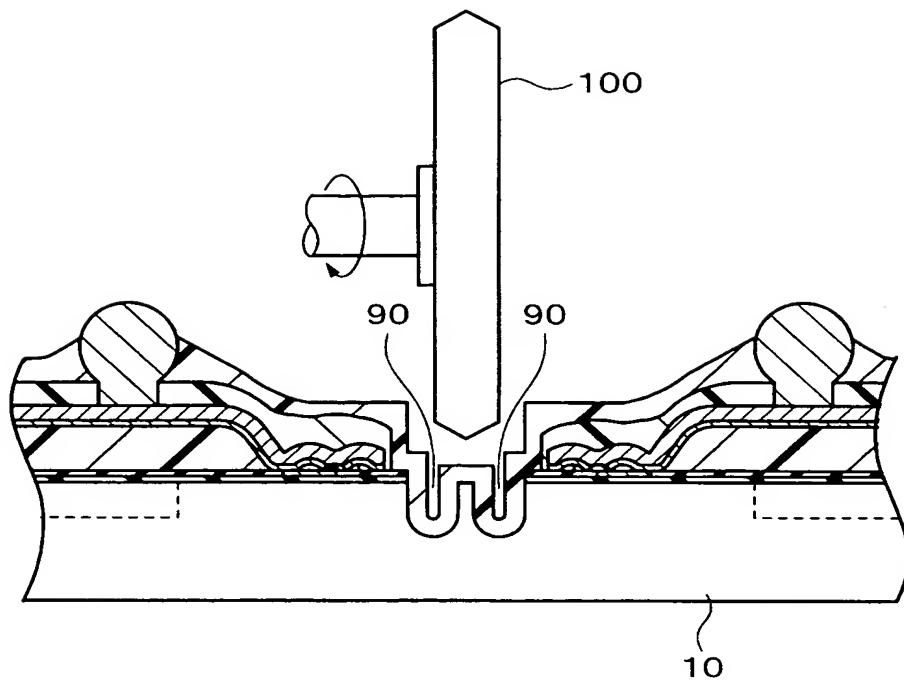
【図 1 1】



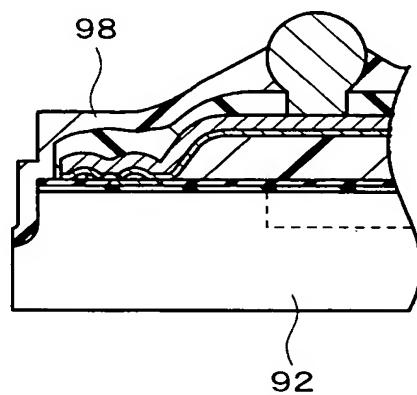
【図 1 2】



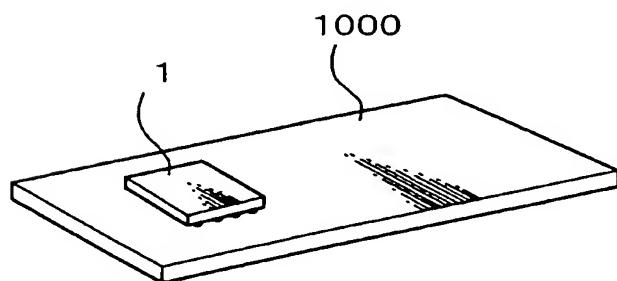
【図13】



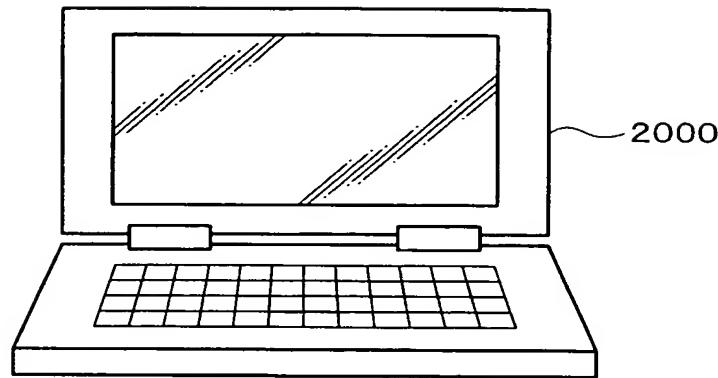
【図14】



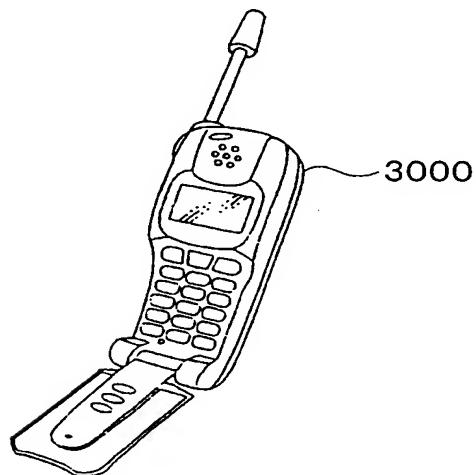
【図15】



【図16】



【図17】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、樹脂層の剥離を防止又は抑制することを目的とする。

【解決手段】 半導体装置は、集積回路12と、集積回路12に電気的に接続する配線と、が形成されており、配線の一部であるパッド16を表面に含む半導体チップ40を有する。半導体装置は、パッド16と電気的に接続してなる再配線層22と、再配線層22の上方に再配線層22に電気的に接続して設けられた外部端子26と、外部端子26を囲むとともに半導体チップ40の側面に至るよう

に設けられてなる樹脂層30と、を含む。

【選択図】 図6

特願 2003-078097

出願人履歴情報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社